大気圧 CVD 法によるβ-Ga₂O₃ナノ構造の成長とフォトルミネッセンス特性 Atmospheric-pressure CVD Growth of β-Ga₂O₃ Nanostructures and

Their Photoluminescence Properties

^O寺迫 智昭¹、大森 裕也²、河崎 雄樹²、佐伯 拓哉²、門田 直己²、宮田 晃²、矢木 正和³ (1.愛媛大院理工、2.愛媛大工、3.香川高専)

^oTomoaki Terasako¹, Yuya Ohmori², Yuki Kawasaki², Takuya Saeki², Naoki Monden²,

Akira Miyata², Masakazu Yagi³

(1. Grad. School Sci. Eng., Ehime Univ., 2. Fac. Eng., Ehime Univ., 3. Natl. Inst. Technol., Kagawa Coll.) E-mail: terasako.tomoaki.mz@ehime-u.ac.jp

1. 序論 β-Ga₂O₃は、~4.9 eV のバンドギャップ エネルギーを有し、パワーエレクトロニクスデバ イス、紫外光検出器、ガスセンサ、蛍光体など様々 な応用が期待されている材料である.近年、材料 のナノ構造化による各種デバイスの高性能化や高 集積化が期待されている.特にガスセンサ応用に おいては、擬一次元ナノ構造化に伴う結晶粒サイ ズの低下がセンシング性能の大幅な向上に寄与す ると期待されている[1].ナノワイヤー(NWs)やナ ノロッド(NRs)のデバイス応用には、そのサイズ及 び形状制御が必須であると言える.

本講演では、ガリウム(Ga)と水(H₂O)を原料に用 いた大気圧 CVD(AP-CVD)法での触媒金属を介し た気相-液相-固相(VLS)成長機構による β-Ga₂O₃ナ ノ構造成長と形状制御の可能性とフォトルミネッ センス(PL)特性について報告する.

2.実験方法 基板には c 面サファイアを用い, 触媒となる Au 薄膜はスパッタリング法によって 堆積した. Ga 原料にはビーズ状 Ga (純度6N) 及びO原料にはフィルタ式純水器で精製した純水 (H2O)を用いた. CVD 用電気炉は1ゾーン横型抵 抗加熱式電気炉であり, Ga ビーズの気化及び基板 の加熱を行った. H2O は電気炉とは別に設けた蒸 発器で気化され, 窒素キャリアガスで反応管内へ 輸送された.成長したナノ構造は,X線回折(XRD;) 測定, 走査型電子顕微鏡(SEM)観察, PL 及び PL 励起スペクトルによって評価した.

3.実験結果と議論 成長した試料の XRD パタ ーンでは、基板のサファイア及び触媒に用いた Au の XRD ピーク以外はすべてβ-Ga₂O₃で指数付け可 能であった. SEM 観察からは、成長温度によって NRs、ニードル状 NRs、NWs 及びナノベルト(NBs) など多様な形状のナノ構造の成長が確認された. これらの構造の多様性には、昇温時の隣接 Au ナ ノ粒子間の合体による粒径の肥大[2]や VLS 機構 と気相-固相(VS)機構の競合[3]が関連すると推測 される. VS 機構の寄与の可能性は, NRs の直径 が成長時間とともに増加することで確認された

Fig. 1 には、一例として Ga₂O₃ NWs の PL スペクトルを示す. ~370 nm (UB)の自己束縛励起子の再結合による紫外線発光[4],~470 nm (BB)の酸素空孔(V₀)ドナーとガリウム空孔(V_{Ga})もしくはV₀-V_{Ga} 複合欠陥アクセプタが関与するトンネルアシステッド・ドナー・アクセプタ対発光[4]及び~530 nm (GB)の外因性不純物の関与が指摘されている緑色発光からなっている[5]. これらの三種類の発光の相対強度は成長条件、すなわちナノ構造の形状によって異なっていた.



Fig. 1. PL spectrum from Ga_2O_3 nanowires (NWs). The inset shows a SEM image of the NWs.

謝辞 本研究は、科学研究費補助金(課題番号: 26390029)の助成のもと行われた.

参考文献 [1] E. Comini, Analytica Chemica Acta 568 (2006) 28. [2] Y. Yan *et al.*, J. Phys. Chem. C 112 (2008) 10412. [3] J. Johansson, Nature Nanotech. 12 (2007) 534. [4] L. Binet, D. Gourier, J. Phys. Chemm Solids 59 (1998) 1241. [5] K. Shimamura *et al.*, Appl. Phys. Lett. 92 (201914) art. no. 201914.